

T-11-09



DIVISION SEMICONDUCTEURS

1N 4370 A → 1N 4372 A
 1N 746 A → 1N 759 A
 ZENER DIODES
 DIODES ZENER

59C 02413 D

400 mW hermetically sealed glass silicon Zener diodes offering the following advantages :

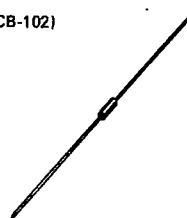
- Voltage range : 2,4 V to 12 V
- Double slug type construction

Diodes Zener au silicium encapsulées verre, de 400 mW offrant les avantages suivants :

- Gamme de tension : 2,4 V à 12 V
- Construction double piston

 $P_{tot} = 400 \text{ mW}$ $2,4 \text{ V} \leq V_{ZT \text{ nom}} \leq 12 \text{ V}$

Case : DO-35 (CB-102)
 Boîtier :



ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

 $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$ $d = 4 \text{ mm}$

(Unless otherwise stated)
 (Sauf indications contraires)

DC power dissipation (see fig. 1) <i>Dissipation de puissance en régime permanent (voir fig. 1)</i>	$T_{amb} \leq 50^\circ\text{C}$	P_{tot}	400	mW
Continuous reverse current <i>Courant inverse continu</i>		I_{ZM}	See page 2 <i>Voir page 2</i>	mA
Operating temperature <i>Température de fonctionnement</i>		T_{oper}	- 65 → + 175	°C
Storage temperature <i>Température de stockage</i>		T_{stg}	- 65 → + 175	°C
Maximum junction temperature <i>Température maximale de jonction</i>	max	T_j	175	°C
Maximum lead temperature for soldering during 10 s at 4 mm from case <i>Température maximum de soudure des connexions pendant 10 s à 4 mm du boîtier</i>		T_L	230	°C

Junction-ambient thermal resistance
Résistance thermique jonction-ambiante

max

 $R_{th(j-a)}$

310

°C/W

December 1983-1/9

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5
 F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE
 Tél. : (1) 788-50-01 Telex : 610560 F

1N 4370 A → 1N 43
1N 746 A → 1N 789 A

59C 02414

DT-11-09

ELECTRICAL CHARACTERISTIC
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

T_{amb} = 25°C d = 4 mm

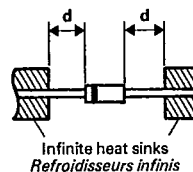
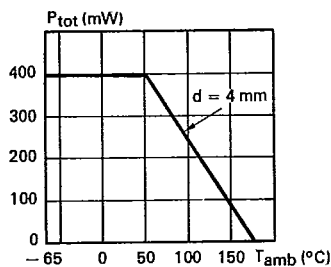
Types	V _{ZT} /I _{ZT} *	r _{ZT} /I _{ZT} *	I _{ZT}	r _{ZK} / I _{ZK}		αV _Z	I _R / V _R		V _R	I _{ZM}
	nom (V)	max (Ω)	(mA)	max (Ω)	(mA)	typ (10 ⁻⁴ /°C)	T _{amb} 25°C max (μA)	T _{amb} 150°C max (μA)	(V)	(mA)
1N 4370 A	2,4	30	20	700	1	- 7	100	200	1	150
1N 4371 A	2,7	30	20	700	1	- 7	75	150	1	135
1N 4372 A	3,0	29	20	700	1	- 7	50	100	1	125
1N 746 A	3,3	28	20	700	1	- 6	10	30	1	115
1N 747 A	3,6	24	20	700	1	- 6	10	30	1	105
1N 748 A	3,9	23	20	700	1	- 5	10	30	1	95
1N 749 A	4,3	22	20	700	1	- 3	2	30	1	90
1N 750 A	4,7	19	20	700	1	- 1	2	30	1	85
1N 751 A	5,1	17	20	700	1	1	1	20	1	75
1N 752 A	5,6	11	20	700	1	3	1	20	1	70
1N 753 A	6,2	7	20	700	1	4	0,1	20	1	64
1N 754 A	6,8	5	20	300	2	4	0,1	20	1	56
1N 755 A	7,5	6	20	300	2	5	0,1	20	1	51
1N 756 A	8,2	8	20	300	2	5	0,1	20	1	46
1N 757 A	9,1	10	20	300	2	6	0,1	20	1	42
1N 758 A	10	17	20	500	0,5	6	0,1	20	1	38
1N 759 A	12	30	20	500	0,5	7	0,1	20	1	31

* Measure under thermal equilibrium and DC current test conditions
Mesure en courant continu à l'équilibre thermique

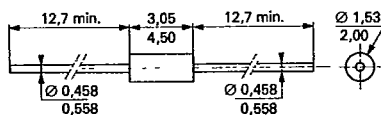
Tolerance on nominal V_{ZT} value : ± 5 %
Tolérance sur la valeur nominale de V_{ZT} : ± 5 %

Forward voltage drop : V_F ≤ 1,5 V @ I_F = 200 mA, T_{amb} = 25°C
Chute de tension directe

FIGURE 1
Maximum power dissipation
Dissipation de puissance maximale



CASE DESCRIPTION
DESCRIPTION DU BOITIER



DO-35 (CB-102)

Weight : 0,15 g
Masse

Marking : clear, ring at cathode end
Marquage en clair, anneau coté cathode